

Cu₂ZnSnS₄ به عناصر فلزی و بازپخت آنها در لایه نازک وگرد به عناصر فلزی و بازپخت آنها در لایه نازک

امیر فوادیان، مهدی عادلی فرد

گروه فیزیک حالت جامد و نانوفیزیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه دامغان

	جار	ول ۲ - تغییرات	خواص الكتريكي	
S/M	ρ قبل بازیخت	ρ بعد بازیخت	R _{sh} قبل بازیخت	بعد بازیخت R _{sh}
3/ IV		$(\Omega.cm)$	$(K\Omega/sq)$	$(K\Omega/sq)$
1	3.3×10^{-1}	7.1×10^{-4}	1.1×10^3	2.3
2	5.4×10^{-1}	5.3×10^{-2}	1.6×10^{3}	1.6×10^{2}
3	4.1×10^{-1}	2.1×10^{-2}	1.2×10^3	6.2×10
نه ضبحا	ت حدول ٢			

تغییرات ویژگیهای الکتریکی به همراه تغییرات S/M قبل و بعد بازیخت

حلیل نتای

با افزایش میزان گوگرد به عناصر فلزی و بازپخت آنها گاف نواری و عبور کاهش یافته و جذب افزایش می یابد. همچنین بازپخت باعث بهبود خواص الکتریکی و بهتر شدن شرایط حاملهای گرمایی می گردد. علت این امر می تواند کم تاثیر کردن تهی جای گوگرد در اثر افزایش گوگرد در محلول اولیه باشد. همچنین تغییرات پس از بازپخت می تواند به دلیل تزریق گوگرد اضافی بین شبکه و همچینن منظم تر شدن ساختارها باشد.

مراجع

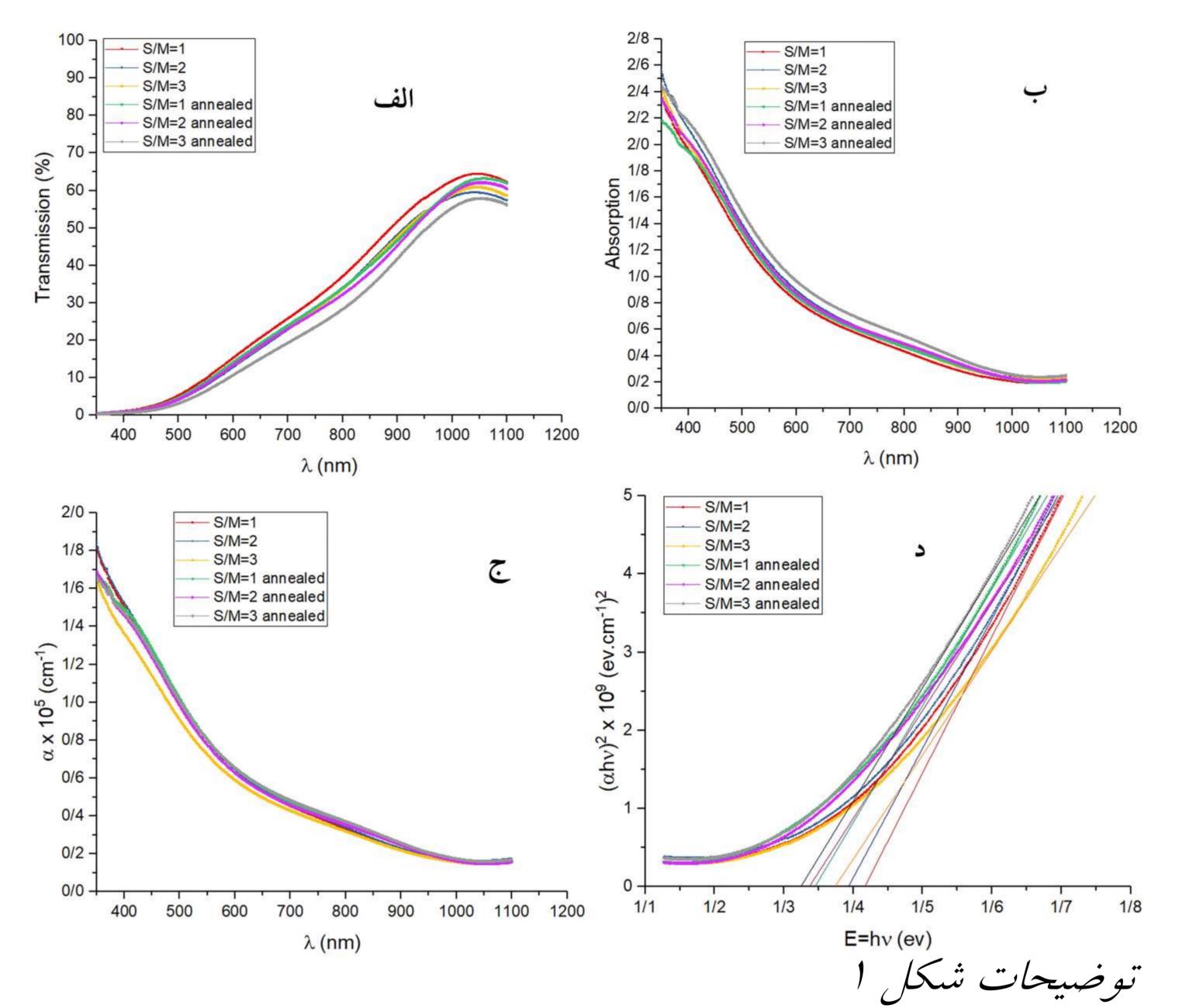
[1] V. Kosyak, N. B. Mortazavi Amiri, A. V. Postnikov, and M. A. Scarpulla, "Model of native point defect equilibrium in Cu2ZnSnS4 and application to one-zone annealing," *J. Appl. Phys.*, vol. **114**, no. 12, 2013.

[2] M. Kumar, A. Dubey, N. Adhikari, S. Venkatesan, and Q. Qiao, "Strategic review of secondary phases, defects and defect-complexes in kesterite CZTS-Se solar cells," *Energy Environ. Sci.*, vol. **8**, no. 11, pp. 3134–3159, 2015.

[3] M. Adelifard, "Nanostructured Cu2ZnSnS4 thin films: influence of substrate temperature on structural, morphological, optical and electrical properties," *Appl. Phys. A Mater. Sci. Process.*, vol. **121**, no. 1, pp. 95–101, 2015.

[4] A. M. S. Arulanantham, S. Valanarasu, K. Jeyadheepan, A. Kathalingam, and I. Kulandaisamy, "Effect of sulfur concentration on the properties of tin disulfide thin films by nebulizer spray pyrolysis technique," *J. Mater. Sci. Mater. Electron.*, vol. **28**, no. 24, pp. 18675–18685, 2017.

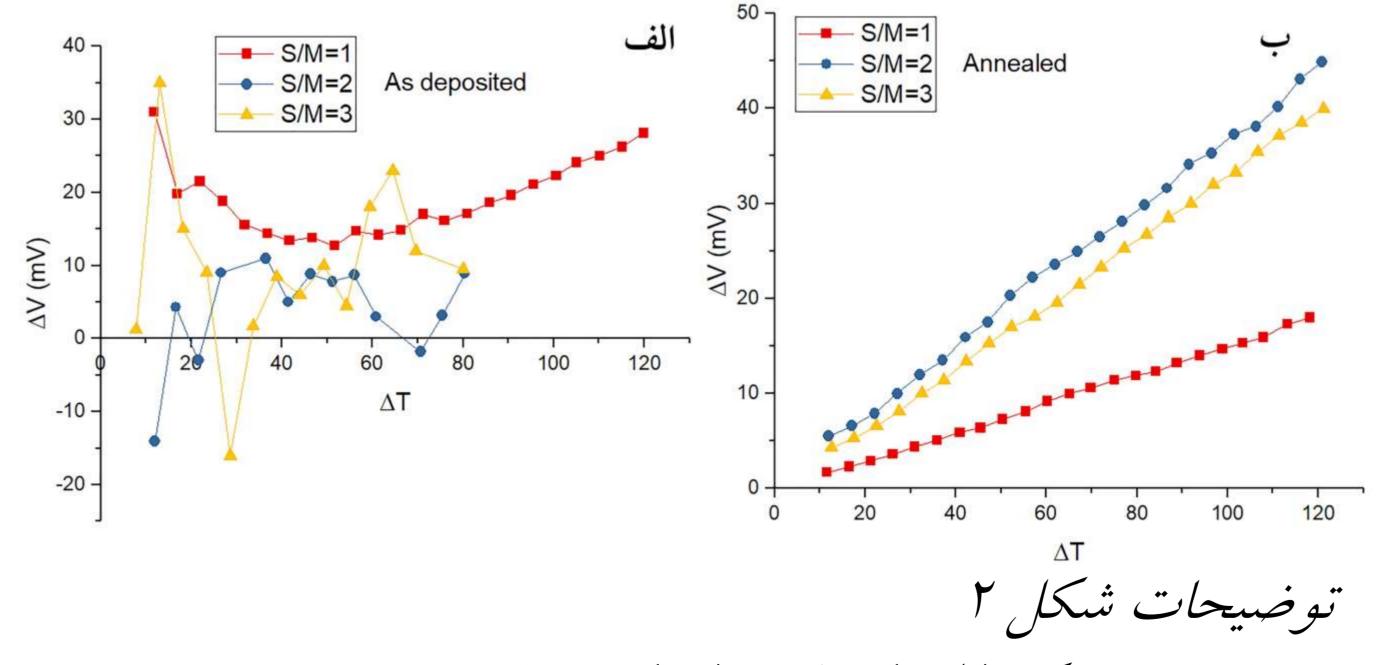
[5] M. Courel, J. A. Andrade-Arvizu, A. Guillén-Cervantes, M. M. Nicolás-Marín, F. A. Pulgarín-Agudelo, and O. Vigil-Galán, "Optimization of physical properties of spray-deposited Cu2ZnSnS4 thin films for solar cell applications," *Mater. Des.*, vol. **114**, pp. 515–520, 2017.



(الف) عبور (ب) جذب (ج) ضریب جذب و (د) گاف نواری لایهها

گاف نواری	جدول ۱ – تغییرات	
گاف نواری (eV)	گاف نواری (eV)	C/NA
بعد از بازیخت	قبل بازیخت	S/M
1.34	1.41	1
1.33	1.39	2
1.32	1.37	3
	المول ا	رضيحات ج

تغییرات گاف نواری به همراه تغییرات S/M قبل و بعد بازپخت



نمودار اثر سیبک (الف) قبل و (ب) پس از بازپخت

در این تحقیق تاثیر تغییر نسبت گوگرد به عناصر فلزی و همچنین بازیخت آنها در نیمرسانای CZTS مورد بررسی قرار گرفته است. همانگونه که کسیاک و همکاران [۱] نشان دادند در نیمرسانای CZTS تهی جای گوگرد V_{S}^{+2} بخصوص در بازیختهای تک زونه غالب می شود بعلاوه طبق تحقیقات کومار و همکاران [۲] تهی جای گوگرد ۷_۶ و سلنیوم V_{Se} دهنده هستند و در صورت رفع این مشکل احتمالاً بتوانیم لایه p-type بهتری را داشته باشیم. در ادامه طبق ادعای عادلی فرد و همکاران [۳] در طی لایه نشانی با روش اسپری پایرولیزیز احتمال از دست دادن گوگرد در دمای بالا وجود دارد. طبق بررسی لایههای SnS₂ ساخته شده به وسیله اسپری پایرولیزیز توسط ارولانانتام و همکاران [۴] مشخص شد با افزایش میزان گوگرد خواص الکتریکی بهبود یافته و همچنین تغییراتی نیز در گاف نواری ایجاد شده است. بعلاوه در تحقیقات کورل و همکاران [۵] بر روی CZTS مشخص گردید که بازیخت در حضور گوگرد می تواند بسیاری از خواص لایه را بهبود ببخشد اما این عمل علاوه بر نیاز به تجهیزات خاص هزینه بر نیز می باشد. لذا در این تحقیق بررسی تغییرات نسبت گوگرد به عناصر فلزی در محلول ساخته شده جهت اسپری و همچنین بازیخت در هوای ازاد به

روش

سه محلول CZTS با تغییرات نسبت گوگرد به عناصر فلزی (مس، روی و قلع) با نسبتهای ۱، ۲ و ۳ در ۵۰ سی سی آب دیونیزه جهت اسپری بر روی زیرلایههای شیشهای با دمای ۳۶۰ درجه سانتی گراد آماده شده و با شرایط ثابت فاصله تا صفحه ۳۰ سانتی متر و آهنگ لایه نشانی ۷ سی سی بر دقیقه اسپری شدند. سپس لایههای بدست آمده در دمای ۳۵۰ درجه سانتی گراد و در هوای آزاد به مدت یک ساعت بازیخت شده و جهت بررسی خواص الکتریکی از آزمایش پروب چهار نقطهای و سیبک و جهت بررسی خواص اپتیکی از دستگاه کالاسرکت شرکت UV-Vis شرکت دانشگاه دامغان استفاده گردید.

عنوان جایگزین روشهای پرهزینه یاد شده مورد بررسی قرار گرفته

نتايج

در ادامه تغییرات اپتیکی و الکتریکی پس از تغییرات S/M و همچنین بازیخت آنها در هوای آزاد آورده شده است.